



当前位置: [首页](#) > [新闻动态](#) > [综合新闻](#)

芬兰倍耐克 (Benecq) 工程师原子层沉积技术及应用报告

2009-11-26 | 编辑: | [【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【打印】](#) [【关闭】](#)

11月24日, 芬兰倍耐克公司 (Benecq) 李烁工程师来我所进行了“原子层沉积技术及应用”的学术介绍, 并与三室师生进行了热烈的讨论与交流。

李烁工程师讲到, 原子层沉积 (atomic layer deposition, ALD), 最初于70年代由芬兰科学家提出, 并用于平板显示器所需的多晶荧光材料ZnS:Mn以及非晶Al₂O₃绝缘膜的研制。多年来, 原子层沉积技术的应用范围从液晶显示面板到工业涂层等多种领域。目前, 正在逐渐成为微电子器件制造领域的必须。它具有单原子层逐次沉积, 沉积层厚度均匀的特点, 可沉积丰富的材料。

通过这次交流, 三室师生受益匪浅, 不仅加深了对原子层沉积技术的了解, 同时又丰富了专业知识, 为今后科研工作的展开打下了良好基础。



[» 评论](#)

通知公告 [MORE](#)

- [中国科学院微电子研究所管理人员招聘启事](#)
- [关于召开第六届研究生会换届选举的通知](#)
- [关于举办中层干部执行力系列培训的通知](#)
- [中国科学院微电子所冬季拔河跳绳比赛通知](#)

新闻动态

- [» 图片新闻](#)
- [» 头条新闻](#)
- [» 综合新闻](#)
- [» 学术活动](#)
- [» 科研动态](#)
- [» 通知公告](#)
- [» 业内信息](#)



中国科学院微电子研究所 版权所有单位名称:中国科学院微电子研究所 单位邮编: 100029
单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn